

11A, 650V 超结 MOS功率管

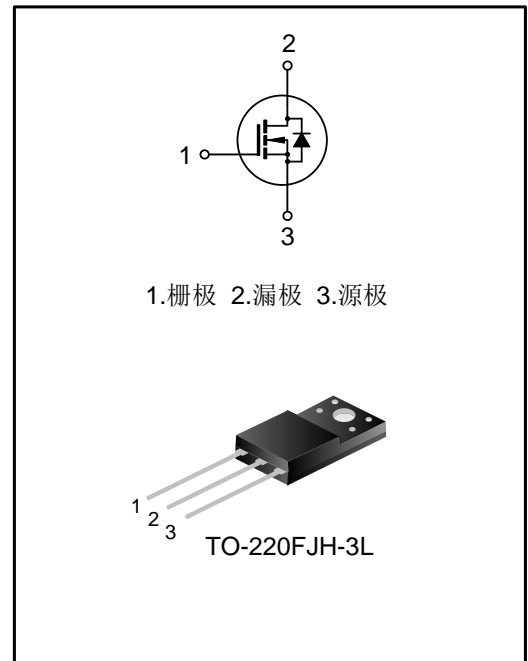
描述

SVSP11N65FJHD2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

此外，SVSP11N65FJHD2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 11A,650V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.33\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVSP11N65FJHD2	TO-220FJH-3L	P11N65FJH	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_A=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	参数值	单位
漏源电压	V_{DS}	650	V
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^\circ\text{C}$	11
		$T_C=100^\circ\text{C}$	7
漏极脉冲电流	I_{DM}	44	A
耗散功率($T_C=25^\circ\text{C}$) -大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	35	W
		0.28	W/ $^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量(注 1)	E_{AS}	250	mJ
反向二极管 dv/dt(注 2)	dv/dt	15	V/ns
MOS管 dv/dt 耐用性(注 3)	dv/dt	50	V/ns
工作结温范围	T_J	-55~+150	$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

热阻特性

参数	符号	参数值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	3.57	$^{\circ}C/W$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}C/W$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}C$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V	
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA	
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA	
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V	
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.5A$	--	0.33	0.4	Ω	
栅电阻	R_g	$f=1MHz$	--	5.2	--	Ω	
输入电容	C_{iss}	$f=1MHz, V_{GS}=0V,$ $V_{DS}=100V$	--	632	--	pF	
输出电容	C_{oss}		--	37	--		
反向传输电容	C_{rss}		--	2.3	--		
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325V, V_{GS}=10V,$ $I_D=11A$	--	12	--	ns	
开启上升时间	t_r						$R_G=24\Omega,$
关断延迟时间	$t_{d(off)}$						(注 4,5)
关断下降时间	t_f						(注 4,5)
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=520V, V_{GS}=10V,$ $I_D=11A$	--	23	--	nC	
栅极-源极电荷量	Q_{gs}						(注 4,5)
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}						(注 4,5)

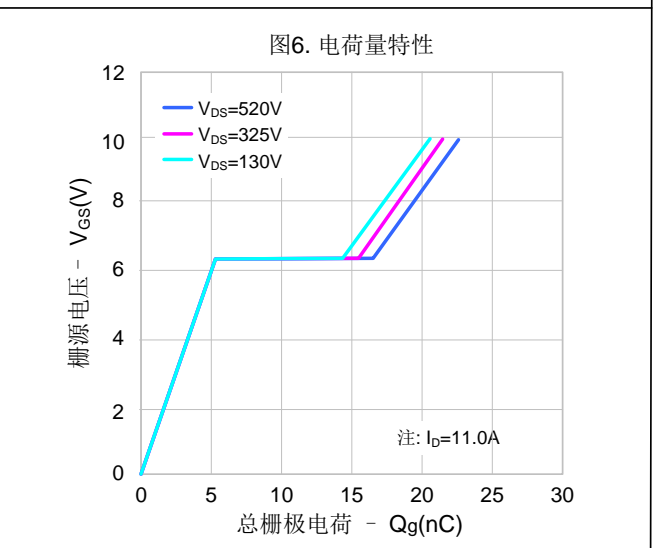
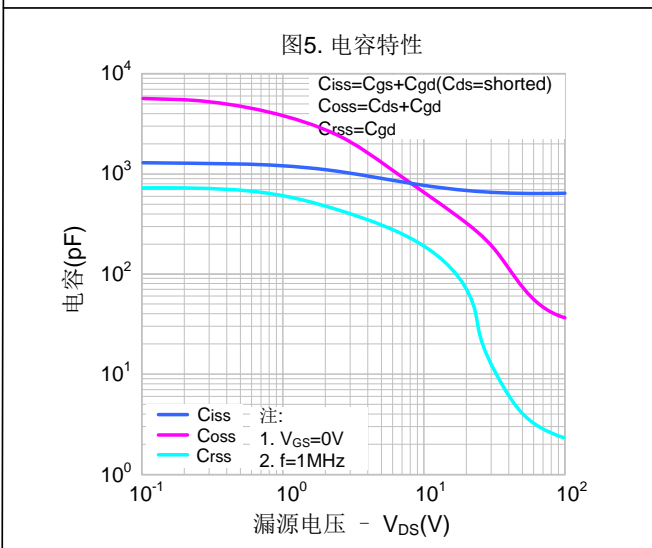
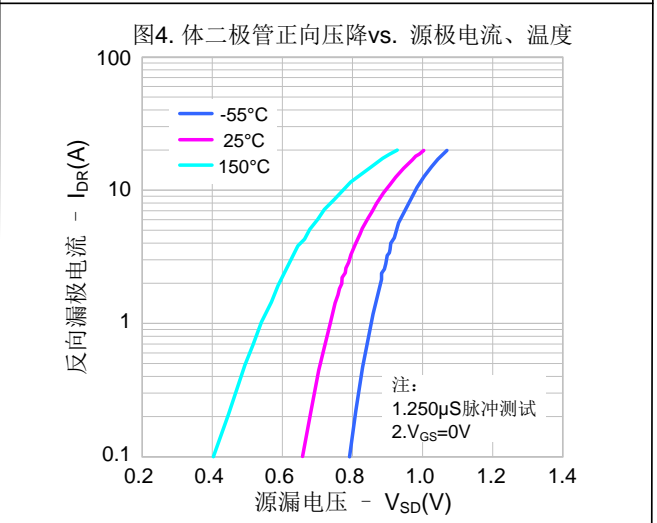
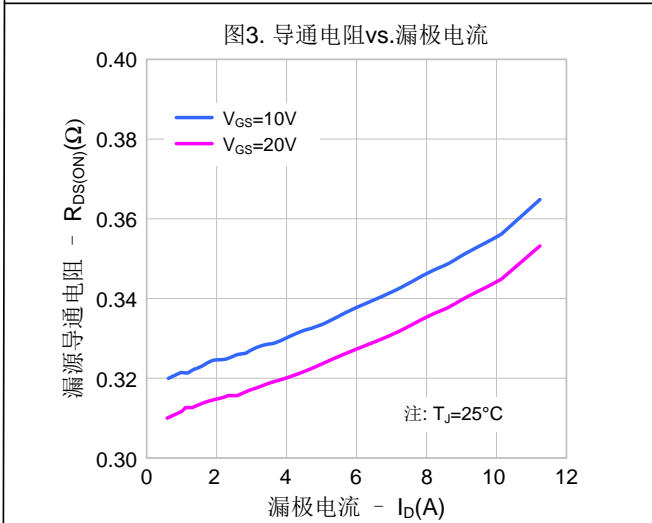
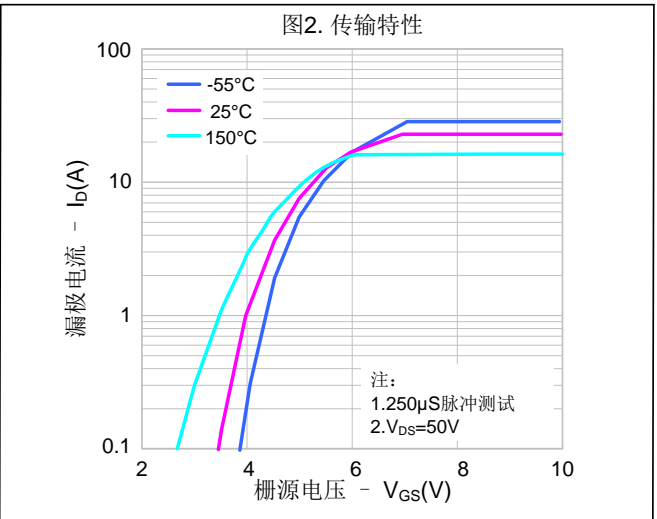
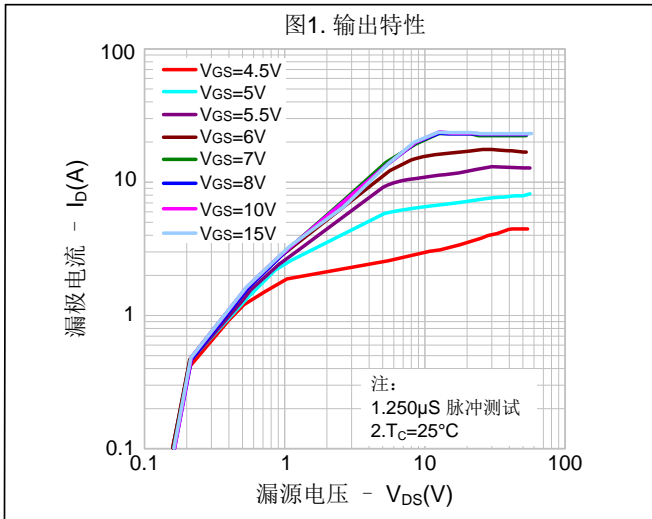
源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	11	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	44	
二极管压降	V_{SD}	$I_S=11A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=11A, V_{GS}=0V,$	--	361	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$di_f/dt=100A/\mu s$	--	3.9	--	μC

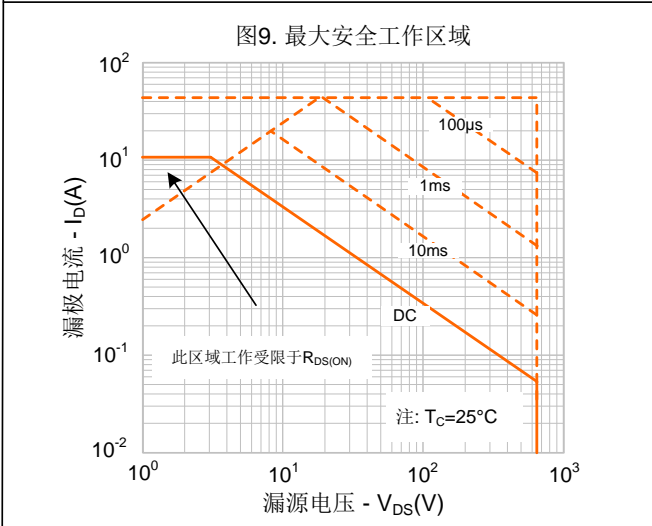
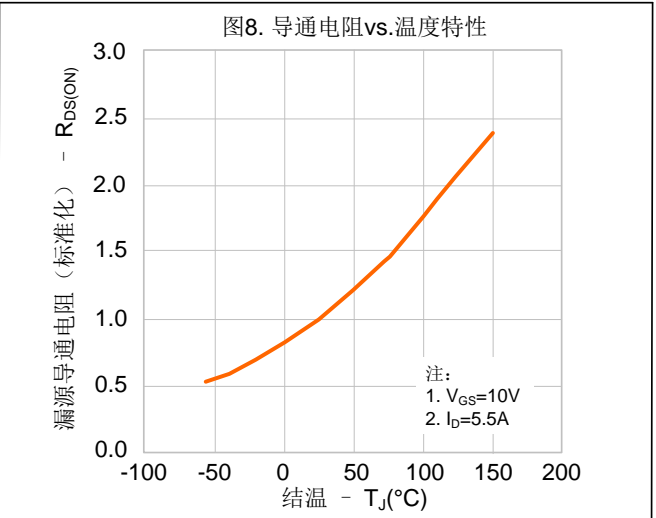
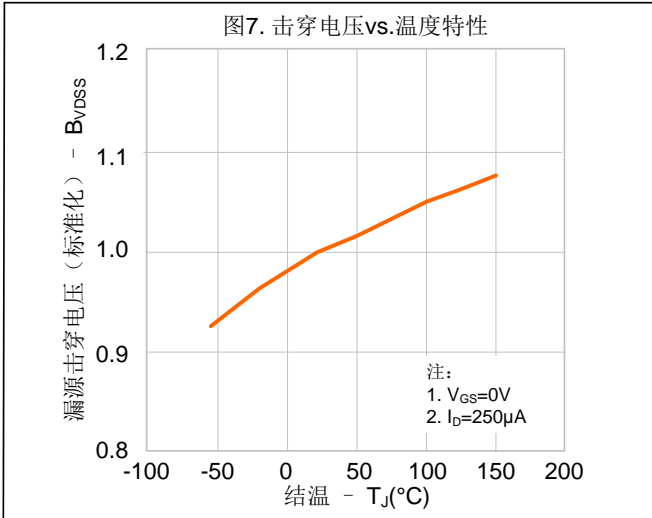
注:

- $L=79mH, I_{AS}=2.4A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}C$;
- $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 11A, T_J=25^{\circ}C$;
- $V_{DS}=0\sim 480V$;
- 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
- 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

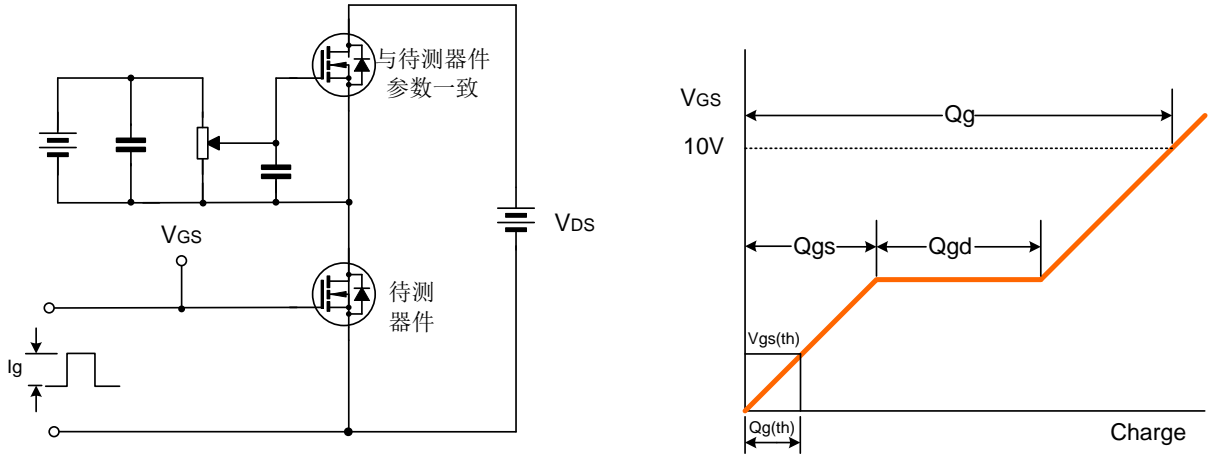


典型特性曲线 (续)

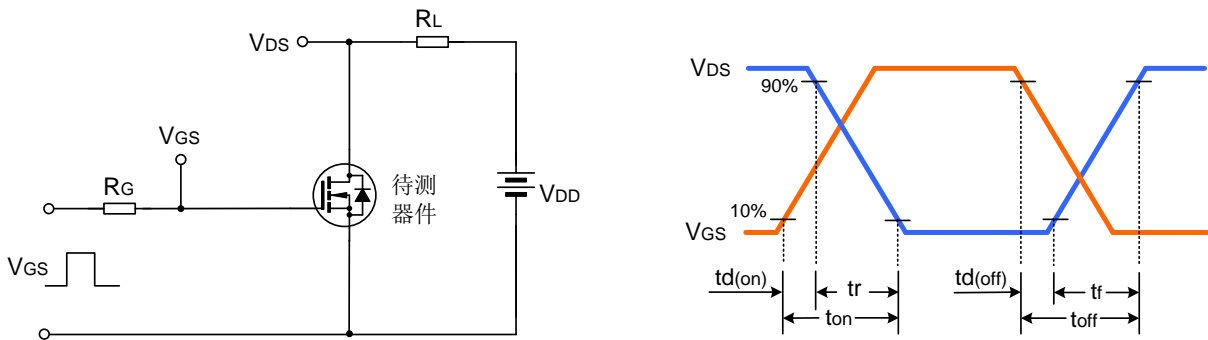


典型测试电路

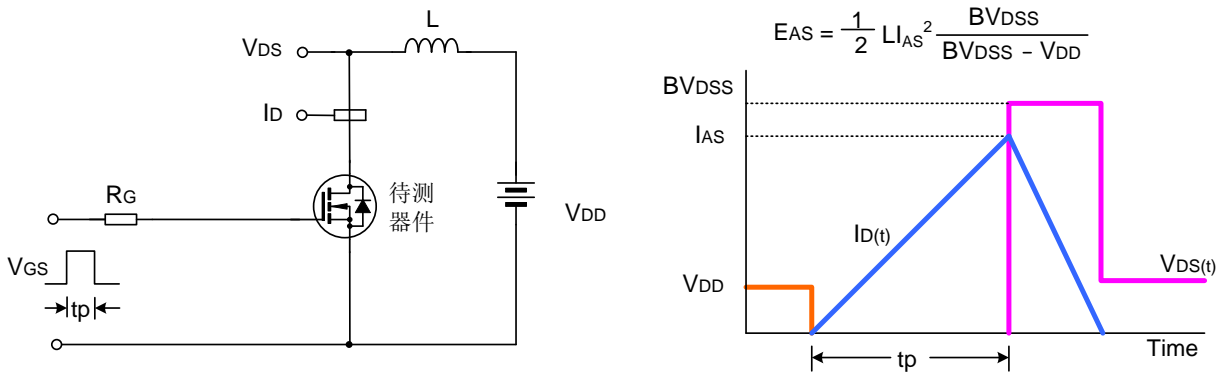
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图

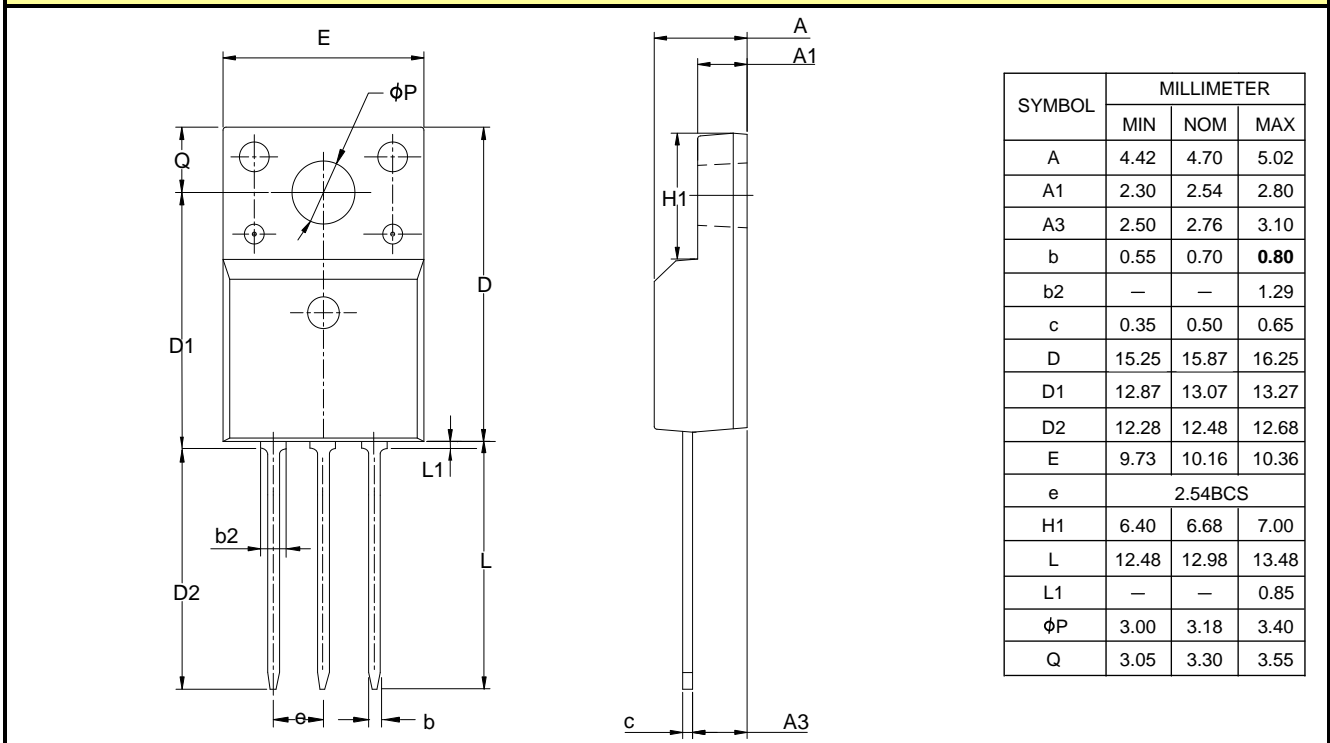


EAS测试电路及波形图



封装外形图
TO-220FJH-3L

单位: 毫米


重要注意事项:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料, 并验证相关信息是否最新和完整。
- ◆ 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- ◆ 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值, 否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- ◆ 购买产品时请认清我司商标, 如有疑问请与本公司联系。
- ◆ 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
- ◆ 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVSP11N65FJHD2	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.1

修改记录:

1. 更新电气图和典型测试电路
 2. 模板更新(更新按比例调整的立体图, 更新标准化后的封装外形图, 更新曲线模板, 更新重要注意事项)
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式发布版本
-
-